

Micron 与 Broadcom 合作以解决 DRAM 时序问题，为网络客户提供改善的性能

协同解决旷日已久的 DDR3 tFAW 时序制约

爱达荷州博伊西，2013 年 12 月 18 日 (GLOBE NEWSWIRE) – 世界领先的先进半导体解决方案提供商之一 Micron Technology, Inc. (纳斯达克代码:MU) 今日宣布其与 Broadcom 合作以为客户开发业界首个针对固有的 DDR3 时序参数问题的解决方案，该时序参数称为 tFAW，即 4 个激活窗口的意思。

tFAW 指的是 DDR3 的一个时序参数，其会限制服务器、存储器和网络应用中的数据流量，可以使带宽降低 15-35%。随着每一代新 DRAM 的出现，访问粒度正在翻倍，使 tRDD 和 tFAW 等一些时序参数限制数据的流量。由于在任何给定的 tFAW 周期内不能发出多于 4 条的库启动命令，这些问题构成对高性能应用的挑战。

“当出现连续的数据过载时，在网络提供者之间搜索增强的性能依然存在着挑战”，IHS iSuppli 内存和 DRAM 高级首席分析师 Mike Howard 说。“能够为高性能应用开启带宽的架构解决方案将有助于提高运行效率和网络整体性能”。

根据 Cisco(R) Visual Networking Index 的预测，从 2012 年至 2017 年，全球 IP 通信量的复合年增长率 (CAGR) 预计可达 23%。

为了满足对带宽势不可挡的强烈需求，全球范围内的服务提供商竞相通过采用更高带宽的链接以改造他们的网络。

通过 Broadcom 验证的 Micron 解决方案处理大小为 2K 字节页的数据时，tFAW 值从 35 纳秒降到 30 纳秒，DDR3-2133 每秒运行能力提高了 18%。这种性能的提高对于复杂的信息包处理功能，例如在服务供应商网络应用中使用的具有高扩展性的 IPv4 和 IPv6 查询能力，是特别重要的。在使用 Micron 的 DDR3 存储器时，该 4 个激活窗口解决方案使 Broadcom 的 BCM88030 200 Gb/s NPU 在网速性能上达到具极高扩展性的 L2、IPv4 和 IPv6 的查找能力。

“目前 OEM 在不断地应对日益增长的容量、速度和数据形式方面的挑战”，Micron 公司 DRAM 营销副总裁 Robert Feurle 说。“我们非常高兴与 Broadcom 一道工作，以验证有助于为我们的互助客户减轻流量压力的解决方案”。

“Broadcom 致力于提供高带宽容量和规模以满足下一代网络的强烈需求”，Broadcom 计算机与连接产品营销高级总监 Dan Harding 说。“通过与 Micron 的合作，我们将不断努力，提供业界最具扩展性的 NPU 解决方案”。

供货信息

Micron 具有缩短 tFAW 时序功能的 2Gb 和 4Gb DDR3 现在开始批量供货。

Micron 是网络市场忠诚的伙伴，拥有大批客户和伙伴协作经验，提供存储器解决方案和能加速连接全世界的网络基础设施建设的系统。欲了解更多信息，请访问 micron.com。

关于 Micron

Micron Technology, Inc., 是全球领先的先进半导体系统供应商。Micron 采用高性能内存技术的广泛产品组合，包括 DRAM、NAND 和 NOR 闪存等，是固态硬盘、模块、多芯片封装及其他系统解决方案的基础。Micron 凭借其 35 年的技术领导地位，为世界最具创新性的计算、消费电子、企业级存储、网络、移动产品、嵌入式和汽车应用提供内存解决方案。Micron 的普通股在纳斯达克上市交易，代码是 MU。欲了解有关美光科技公司的更多信息，请访问 www.micron.com。

联系方式: Zeno Group for Micron

Mary Ellen Ynes

maryellen.ynes@zenogroup.com

650-801-7954